



计算机组成原理

第四章 存储子系统





主要内容

- 1 概述
- 2 半导体存储器
- 3 主存储器组织
- 4 磁表面存储器



4.1 概述

- 01. 存储器的层次结构
- 02. 存储器的分类
- 03. 存取方式

计算机的重要特点之一是具有**存储能力**，这是它能够**自动连续**执行程序，进行广泛信息处理的重要基础。

本章需解决的主要问题：

- (1) 存储器如何存储信息？
- (2) 在实际应用中如何用存储芯片组成具有一定容量的存储器？

存储器是用来存放大量程序与数据的计算机部件。

存储系统特别是**主存储器与CPU**之间有大量的信息交换操作，
因此对存储器最基本的要求有三点：

存储容量大、存取速度快、成本低价格低

计算机的工作表现为读取与执行指令：

1. 执行指令是在CPU内完成，
2. 读取指令是在存储器中完成的，

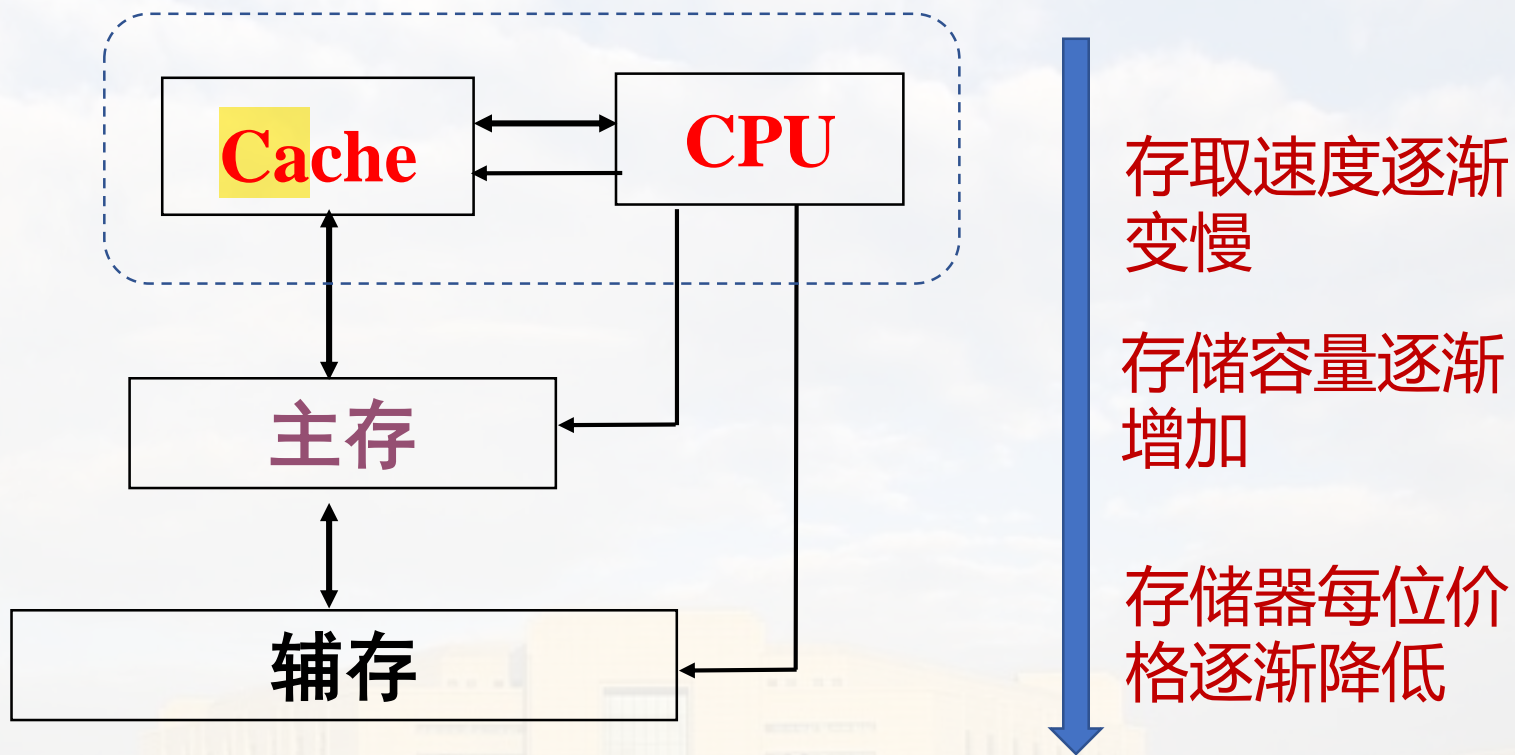
但因两者**速度不匹配**，造成了所谓的“瓶颈”问题。

解决“瓶颈”的方法：

- ① 再努力改进制造工艺，寻求新的存储机理，以提高存储器的性能；
- ② 采用**存储器分层结构**来满足计算机系统对存储器不同方面的要求。

典型的**三级存储体系结构**，分为“**高速缓冲存储器-主存-外存（辅存）**”三个层次。

一、存储器的层次结构



1、主存储

能由CPU直接编程访问的存储器，它存放当前CPU需要执行的程序与需要处理的数据。

特点：存取速度快，容量有限

为满足CPU编程直接访问的需要，对主存储器的基本要求有三条：

(1)随机访问

(2)工作速度快

(3)具有一定的存储容量

2、外存储器（辅助存储器）

用来存放需要联机保存但暂不使用的大量程序与数据。

特定：存取速度较慢，容量很大

程序与数据只有进入主存才能真正运行，
而外存储器是作为后援的。

3、高速缓存：

高速缓存中存放的是最近要使用的程序与数据，作为主存中当前活跃信息的副本。

特点：存取速度快，容量小

4、层次结构

1) 主存-Cache层次 需解决:

① 地址映射

a. 直接映射:

主存的每一块只能映射到Cache的固定块中。

b. 全相联映射

主存的每一块可以映射到Cache的任一块。

c. 组相联映射

主存的每一块可以映射到Cache的多个固定块。

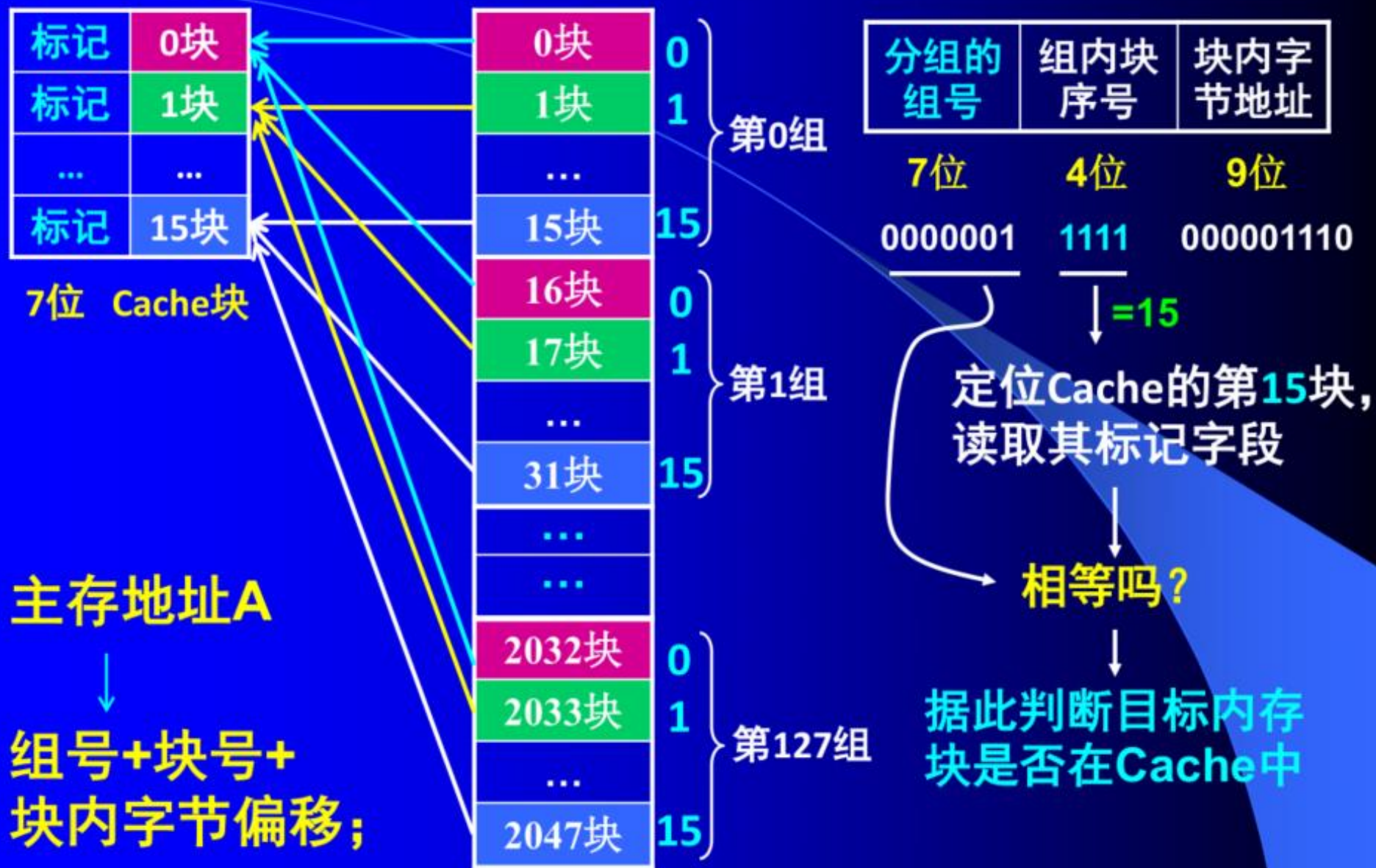
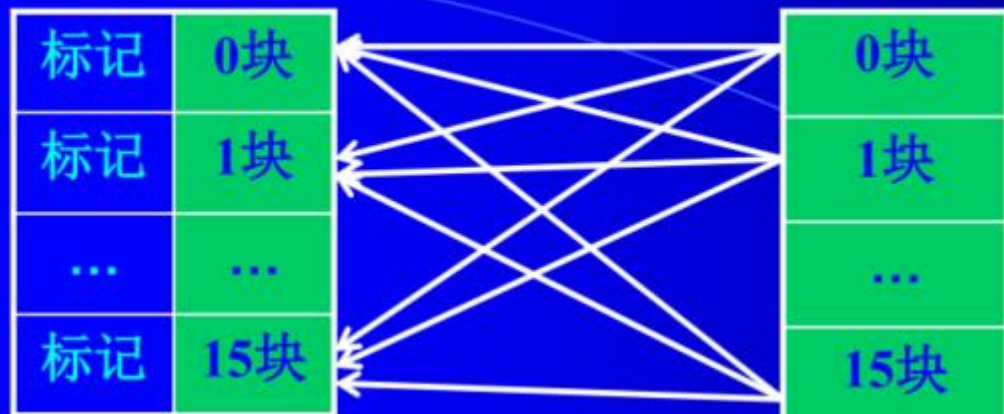


图4-47 直接映射 $C=4$ 、 $N_a=20$, 每块512字节



11位 Cache块

主存地址A

↓
第几块中的
第几个地址?

主存

主存块号	块内地址
------	------

11位

9位

00000011111 000001110

=31

将主存块的块号与Cache块的标记字段比较，判断主存块是否已映射到缓存中

图4-48 全相联映射 $N_a=20$ ，每块512字节

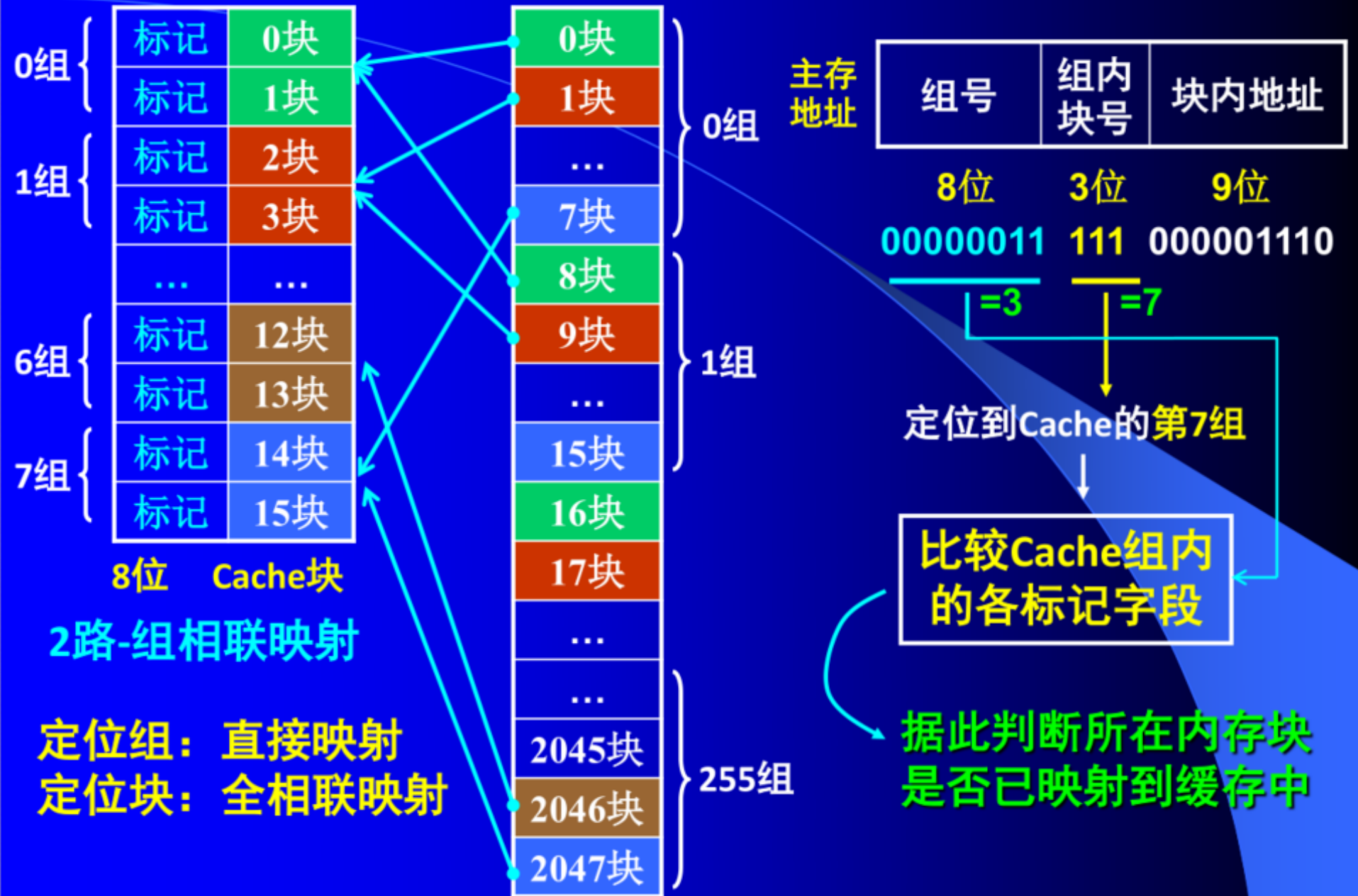


图4-49 组相联映射 $N_a=20$, 每块512字节

② 访问命中

$$\text{命中率} = \frac{\text{访问命中次数}}{\text{访问次数}} \times 100\%$$

③ Cache内容替换

- 先进先出(FIFO, First Input First Output)
- 最不经常使用(LFU, Least-Frequently Used)
- 近期最久未使用(LRU, Least-Recently Used)

④ 数据一致性

数据一致性就是通过读写，使得cache的数据和主存的数据保持一致。

(1) 读操作

- 旁路式读
- 通过式读

(2) 写操作

- 回写法
- 通写法

当Cache写 未命中时，该如何处理？

2) 主存-外存层次

虚拟存储：主存+部分外存→虚存

用户编程空间

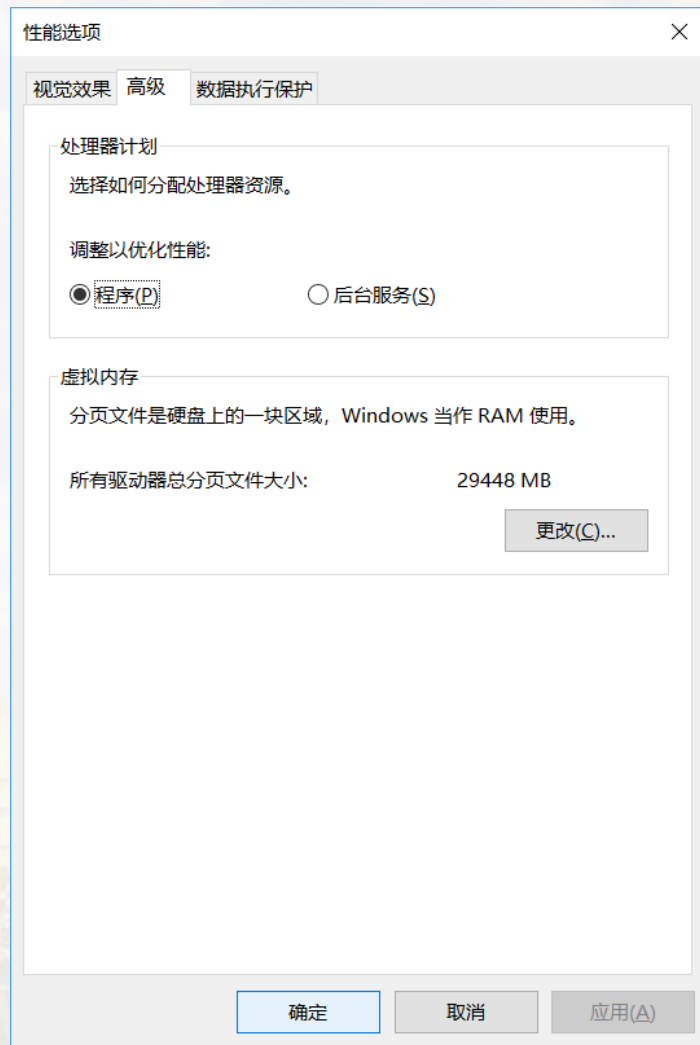
虚拟存储器的主要思想是把可访问的逻辑地址空间和实际的物理内存空间区分开，通过某种技术手段将外存数据与内存区域关联，让用户通过较小容量的内存来访问到较大容量的外存数据。

一、存储器的层次结构

用户可在这个大空间里自由编程，不受主存容量限制，也不必考虑所编的程序将来在主存中的实际位置。

CPU执行程序时，按照程序提供的虚地址访问主存。因此，需解决：

- ① 存储空间分配
- ② 程序调度
- ③ 虚-实地址转换



虚拟存储器是从用户界面上透明可见和可用的存储空间，并不是真实物理存在的，更不是外部存储器与主存的简单拼合。从编程的角度看，用户使用虚拟存储空间就如同使用主存一样，而内部的调度管理和信息交换则是由操作系统和硬件一起配合实现的。

1、物理存储机制

凡是明显具有并能保持两种稳定状态的物质和器件，如果能够方便地与电信号进行转换，就可以作为**存储介质**。

存储介质**种类**：

(1)磁芯存储器

基本单位：微型磁环，上世纪50年代---70年代。

(2)半导体存储器

是构成高速缓存、主存的单元。

1) 静态存储器：是依靠双稳态触发器的两个稳定状态保存信息。

2) 动态存储器：是依靠电容上的存储电荷暂存信息。

从集成电
路的类型
划分

双极型

ECL

特点：存取速度非常快，功耗大，集成度很低，如CACHE

TTL

MOS型

NMOS

特点：速度快，功耗较低，集成度较高

CMOS

特点：速度较快，功耗很低，集成度很高

MOS:complementary metal oxide semiconductor, 互补氧化金

属半导体

(3)磁表面存储器

利用磁层上不同方向的磁化区域表示信息。容量大，非破坏性读出，长期保存信息，速度慢，作外存。

是构成外存的单元之一，分为：磁卡、磁鼓、磁带、磁盘等。

(4)光盘存储器

利用光斑的有无表示信息。容量很大，非破坏性读出，长期保存信息，速度慢，作外存。

- 1) 只读型光盘 (CD-ROM)
- 2) 写入式 (只能写一次) 光盘 (WORM)
- 3) 可擦除/重写型 (可逆式) 光盘

2、存取方式分类

(1)随机存取存储器 (RAM) : random access memory

主存与高速缓存Cache是CPU可以直接编址访问的存储器，这就要求它们采取随机访问的存取方式。

随机存取的**含义**有两点：

① 可按地址随机地访问任一存储单元，如可直接访问0000单元，也可直接访问FFFF单元；CPU可按字节或字存取数据，进行处理。

② 访问各存储单元所需的读/写时间相同，与地址无关：

可用读/写周期（存取周期）表明RAM的工作速度。

速度指标：存取周期或读/写周期。

用作主存、高速缓存。

(2)只读存储器（ROM）：read only memory

只读存储器在正常工作中只能读出，不能写入。主存中常采用部分ROM固化系统软件中的核心部分、已调试好不再改变的应用软件、汉字字库一类信息。掉电后信息可以保存。

CPU中也常采用ROM，存放用来解释执行机器指令的微程序。

RAM：可读可写

ROM：只读不写

固存：用户不能编程

PROM：用户可一次编程

EPROM：用户可多次编程
(紫外线擦除)

EEPROM：用户可多次编程 (电擦除)

Flash Memory

RAM和 ROM的评价指标:

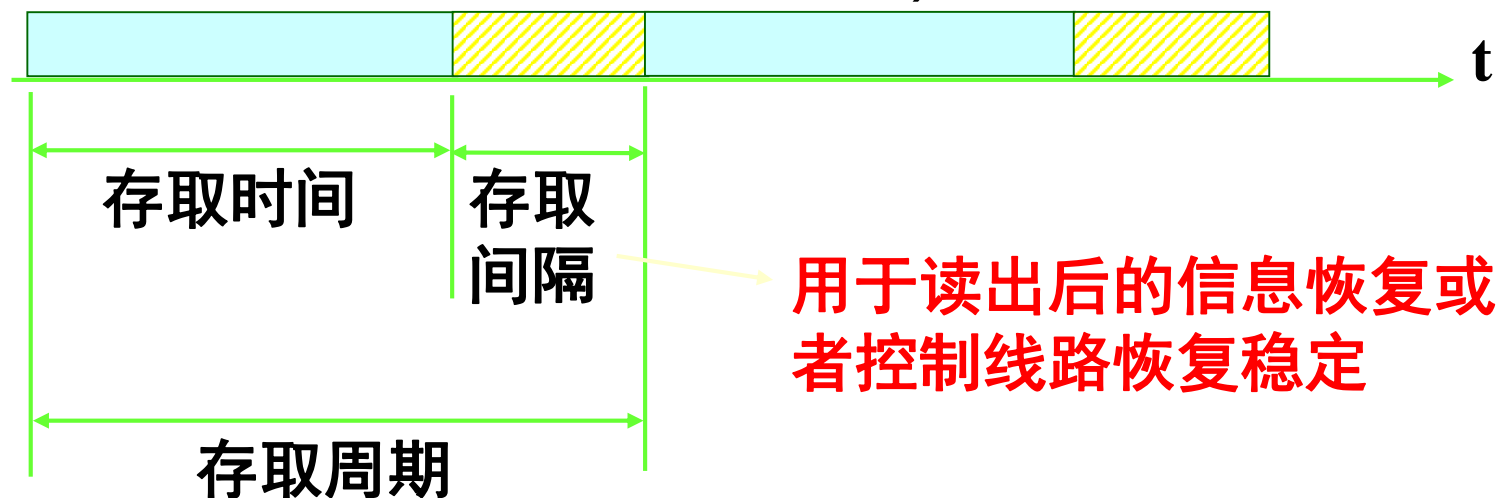
① 存取时间

从存储器收到地址到数据写入存储器或者读出的数据可用为止所需要的时间。是反映存储器速率的指标。

存取时间 — 用 T_A 表示(一般为ns级)

② 存取周期

连续访问存储器时, 两次访问之间的间隔时间 (标记-7, -15, -45, 分别表示7,15,45ns)。



注: 按随机存取存储器的定义, RAM 和ROM都是随机存取存储器, 因为访问时间都与所访问地址单元无关。

(3) 顺序存取存储器 (SAM) : sequential access memory

顺序存取存储器的信息是按记录块组织、顺序存放的，访问时间与信息存放位置有关。

磁带是采取顺序存取方式的存储器。

两步操作 { 等待操作
读/写操作

速度指标 { 平均等待时间 (ms)
数据传输率 (字节/秒)



(4) 直接存取存储器 (DM): direct access memory

访问时读/写部件先直接指向一个小区域，再在该区域内顺序查找。访问时间与数据位置有关。

三步操作 { 定位（寻道）操作
等待（旋转）操作
读/写操作

速度指标 { 平均定位（平均寻道）时间（ms）
平均等待（平均旋转）时间（ms）
数据传输率（位/秒）



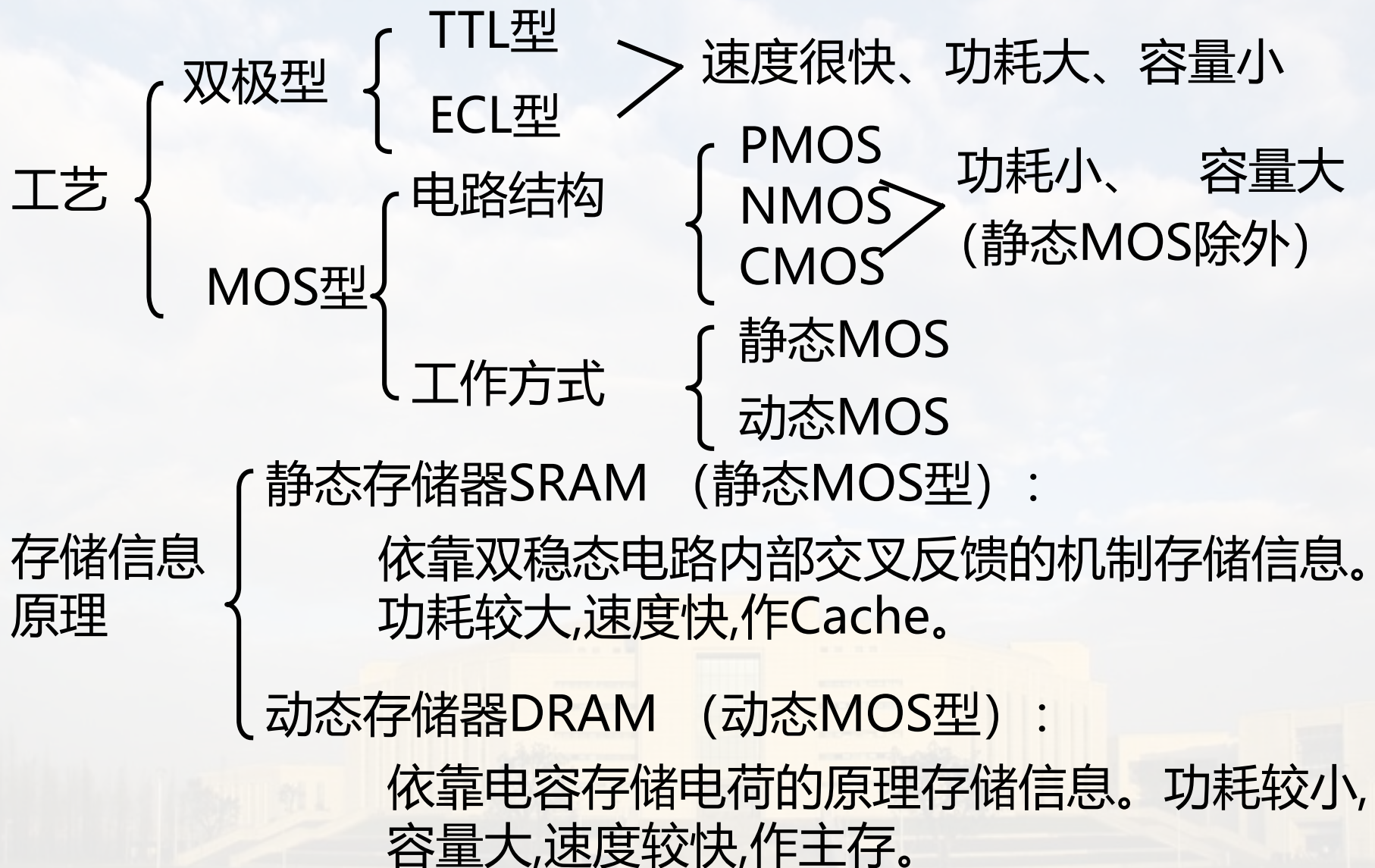
主要内容

- 1 概述
- 2 半导体存储器
- 3 主存储器组织
- 4 磁表面存储器



4.2 半导体存储器

- 01. 静态MOS存储单元与芯片（SRAM）
- 02. 动态MOS存储单元与存储芯片



一、静态MOS存储单元与芯片 (SRAM)

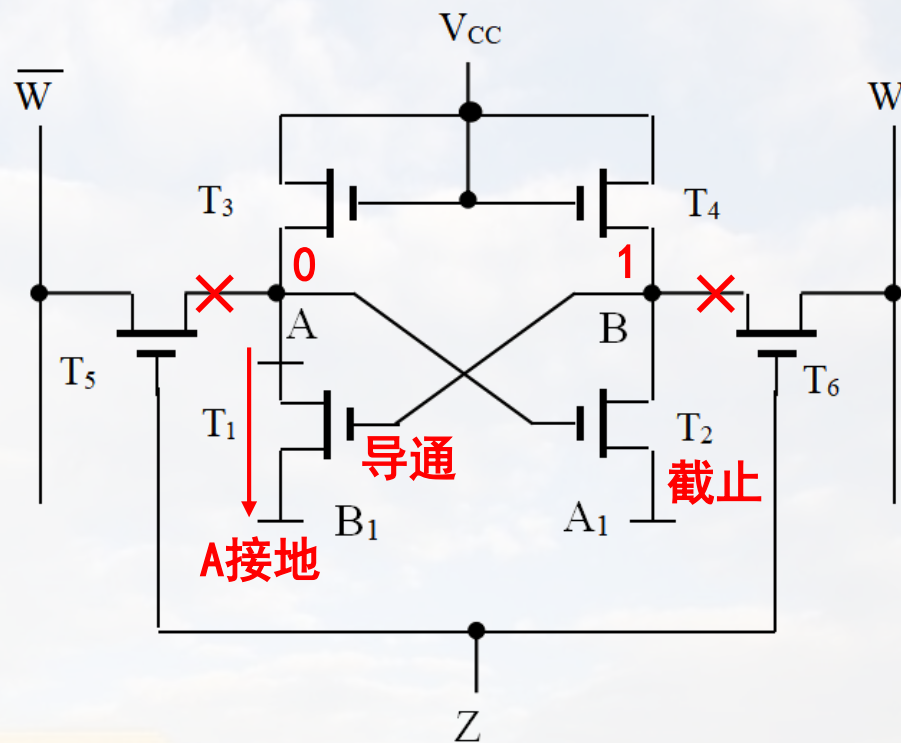
1. 六管单元 (了解)

(1) 组成

T1、T3: MOS反相器

T2、T4: MOS反相器

双稳态触发器



NMOS 六管静态存储单元

一、静态MOS存储单元与芯片 (SRAM)

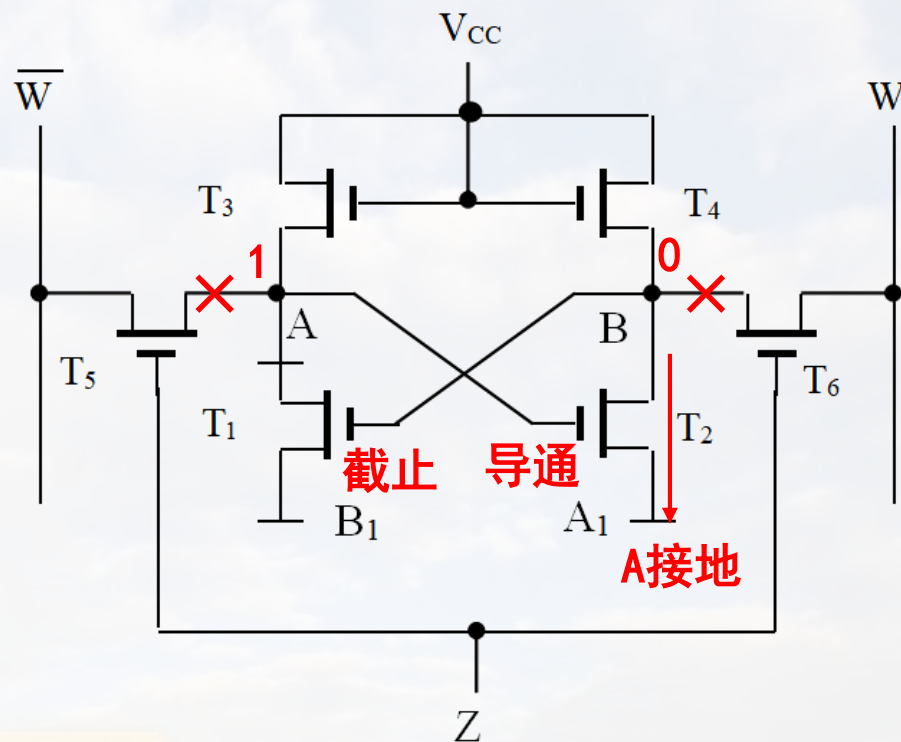
1. 六管单元

(1) 组成

T1、T3: MOS反相器

T2、T4: MOS反相器

双稳态触发器



NMOS 六管静态存储单元

(1) 组成

T2、T4: MOS反相器

双稳态触发器

T5、T6：控制门管

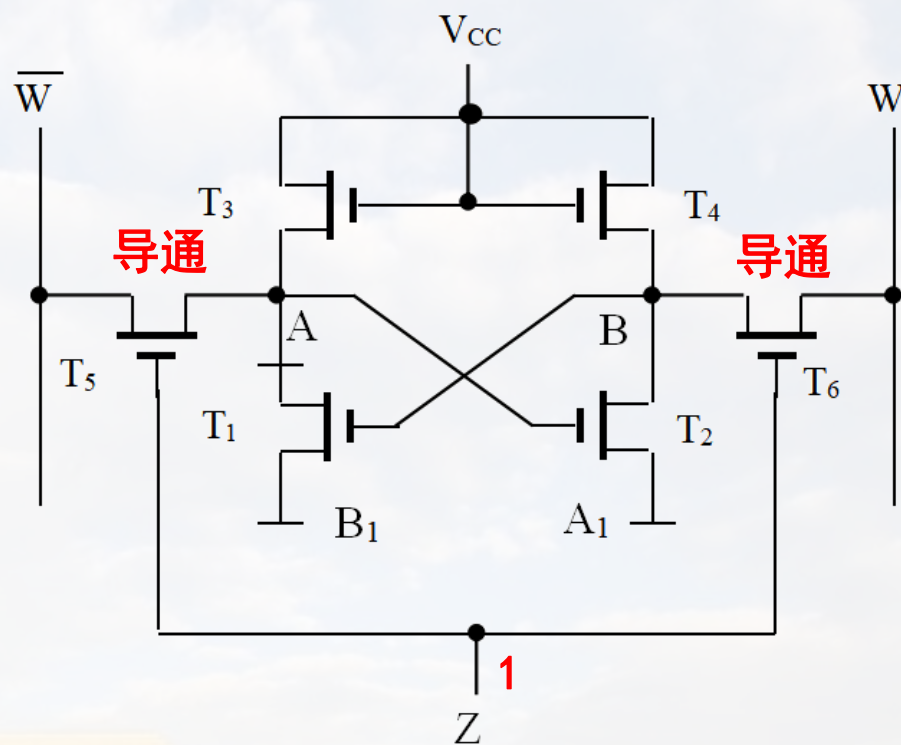
Z: 字线, 选择存储单元

\overline{W} 、 W : 位线, 完成读/写操作

(2) 定义

"0" : T1导通, T2截止;

"1" : T1截止, T2导通。



NMOS 六管静态存储单元

一、静态MOS存储单元与芯片 (SRAM)

(3)工作

1) 写入:

首先字线Z加高电平时,
 T_5 、 T_6 导通, 选中该单元。

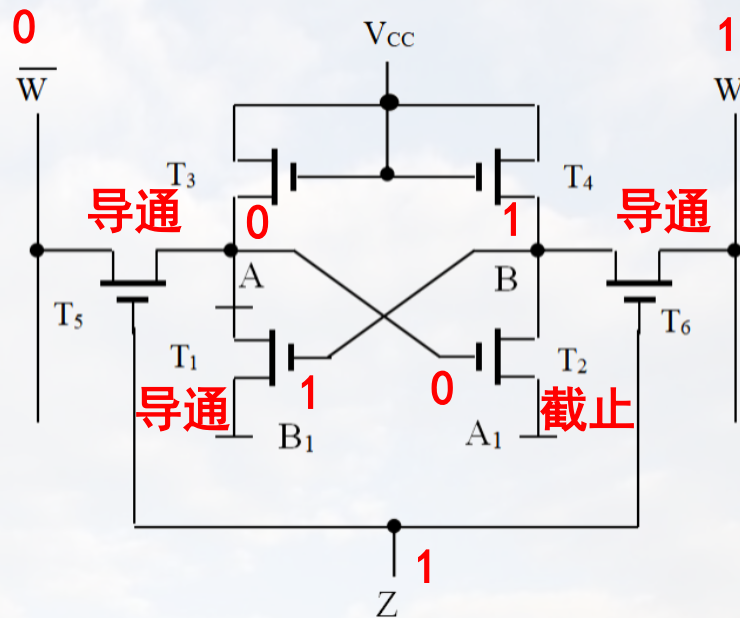
写 “0” , \bar{W} 低电平, W 高电平:

a. \bar{W} 加低电平,

则: \bar{W} 通过 T_5 使A点放电,
 A变为低电平 $\rightarrow T_2$ 截止;

b. 同时, W 加高电平, 通过 $W \rightarrow T_6 \rightarrow B$ 加高电平,
 使 T_1 导通。

T_1 导通, T_2 截止: 电路处于 “0” 状态



一、静态MOS存储单元与芯片 (SRAM)

写“1”， \bar{W} 高电平， W 低电平：

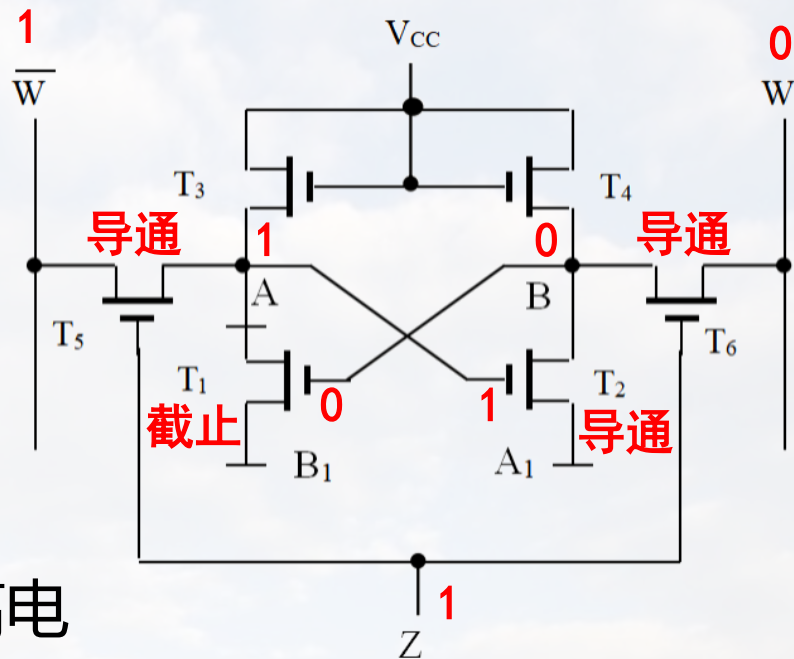
a. W 加低电平，

则： W 通过 T_6 使 B 放电，

使 B 变为低电平→ T_1 截止；

b. \bar{W} 加高电平,通过 $\bar{W} \rightarrow T_5 \rightarrow A$ 加高电平，使 T_2 导通；

T_2 导通， T_1 截止： 电路处于 “1” 状态



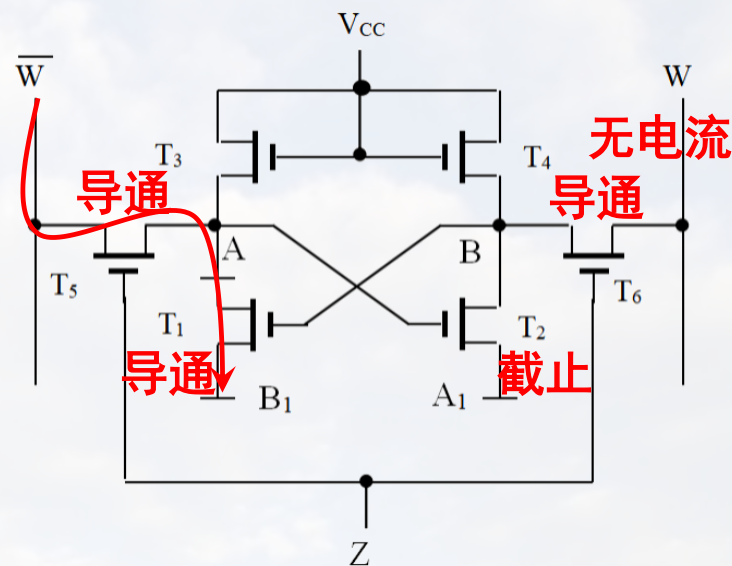
一、静态MOS存储单元与芯片 (SRAM)

2) 读出:

先对位线 W 、 \bar{W} 充电至高电平, 该电平是浮动的, 可随充放电而变; 然后对字线 Z 加高电平, 使 T_5 、 T_6 导通。

读“0” (即 T_1 导通):

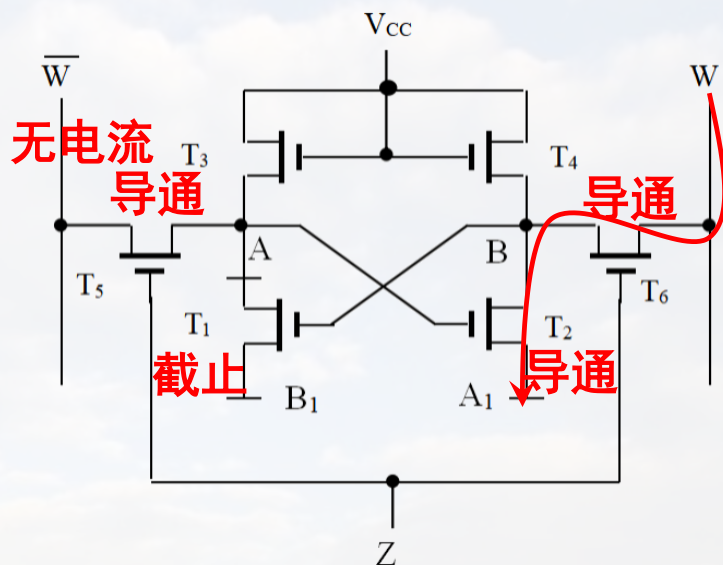
位线 \bar{W} 上的 \bar{W} 电压 $>$ V_A 的电压, 则 $\bar{W} \rightarrow T_5 \rightarrow A \rightarrow T_1 \rightarrow$ 地, 形成放电回路, 即有电流经 $\bar{W} \rightarrow T_1$, 经放大为“0”信号, 表明原存储信息为0。此时 T_2 截止($V_{A1} = V_A = 0$), W 上无电流。



一、静态MOS存储单元与芯片 (SRAM)

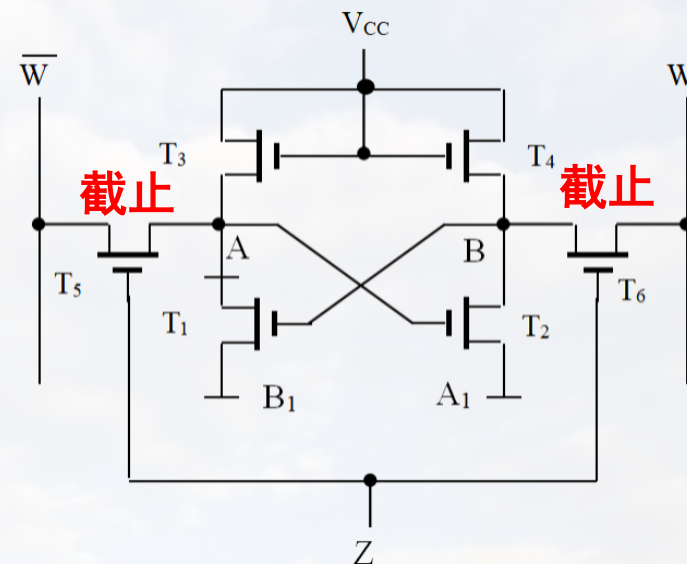
读“1” (即 T_2 导通) :

位线 W 上的 W 电压 $> V_B$ 的电压,
则 $W \rightarrow T_6 \rightarrow B \rightarrow T_2 \rightarrow$ 地, 形成放电回路,
即有电流经 $W \rightarrow T_2$, 经放大为
“1” 信号, 表明原存储信息为1。此时 T_1 截止($V_{b1} = V_b = 0$), \bar{W} 上无电流。



3) 保持:

字线Z加低电平, 门管 T_5 与 T_6 断开, 位线与双稳态电路隔离, 双稳态电路依靠自身的交叉反馈保持原有状态不变。



总之, \bar{W} 上有电流为0, W 上有电流为1。上述读出过程并不改变双稳态电路原有状态, 属于非破坏性读出。

一、静态MOS存储单元与芯片 (SRAM)

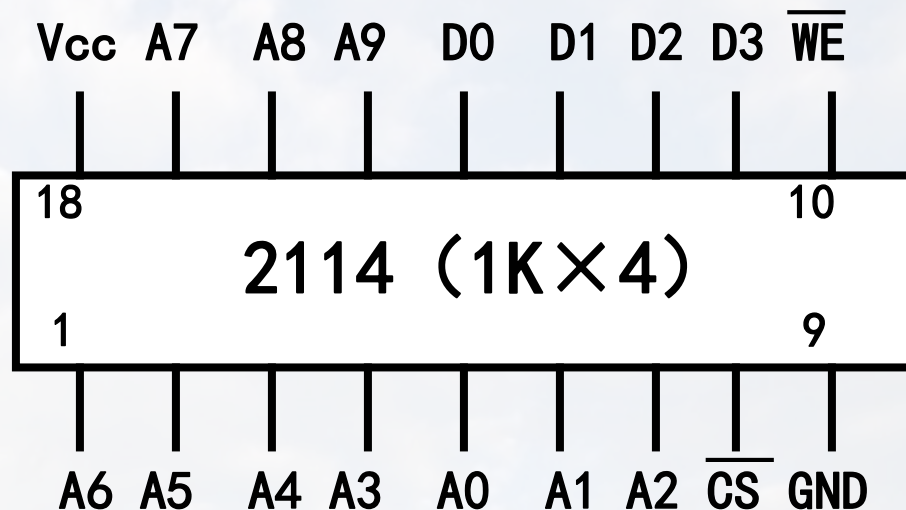
2、存储芯片

例如：SRAM芯片2114

(1K×4位) 外部特性

地址端：A9~A0 (入)

数据端：D3~D0 (入/出)



控制端：

- 片选 \overline{CS}
 - = 0 选中芯片
 - = 1 未选中芯片
- 写使能 \overline{WE}
 - = 0 写使能
 - = 1 读使能

电源、地

1、动态MOS存储器的基本存储原理

是将存储信息以**电荷形式**存于电容之中，这种电容可以是MOS管栅极电容，或者是专用的MOS电容，通常定义电容充电至高电平时为1；放电至低电平时为0。

2、概念

1) 刷新：

时间过长，电容上的电荷会通过泄漏电路放电，使所存储的信息丢失。为此，经过一定时间后就需要对存储内容重写一遍，也就是对存1的电容重新充电，称为刷新。

2) 重写(再生):

对于单管动态MOS存储单元而言，读操作后C上的电荷将发生变化，属于破坏性读出，需要读后对存1的电容补充电荷，称为重写(再生)。这一过程，由芯片内的外围电路自动实现。

3、动态MOS四管存储单元电路（非双稳态电路）

1) 组成

T_1 、 T_2 ：记忆管

C_1 、 C_2 ：栅极电容

T_3 、 T_4 ：控制门管

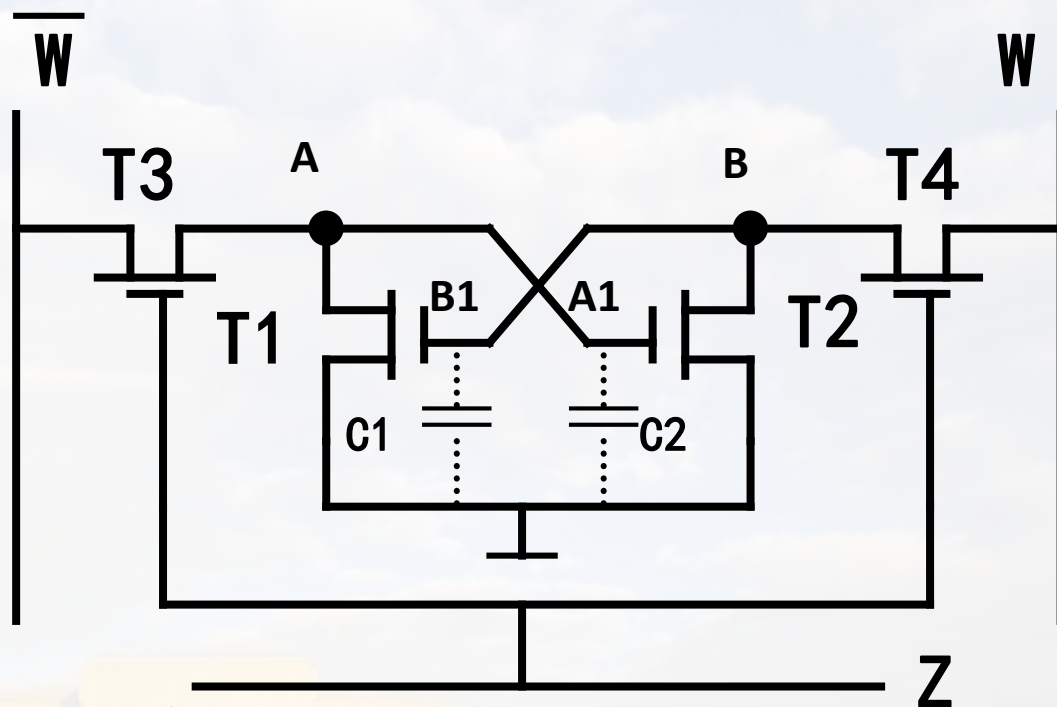
Z：字线

\bar{W} 、 W ：位线

2) 定义

“0”： T_1 导通， T_2 截止（ C_1 有电荷， C_2 无电荷）；

“1”： T_1 截止， T_2 导通（ C_1 无电荷， C_2 有电荷）。



3) 工作

① 写入

首先字线Z加高电平时,
 T_3 、 T_4 导通。

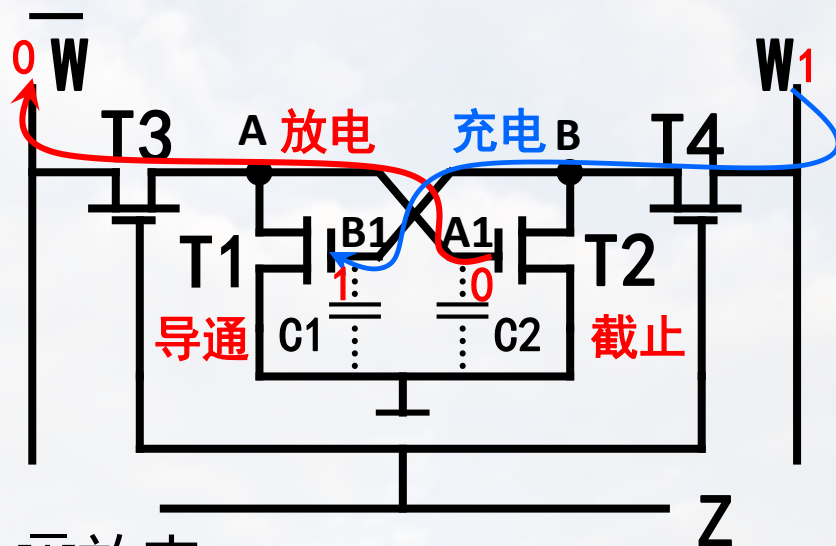
写“0”：

a. \bar{W} 加低电平, $C_2 \rightarrow A_1 \rightarrow A \rightarrow T_3 \rightarrow \bar{W}$ 放电

(使 V_{A1} 变为低电平 $\rightarrow T_2$ 截止;)

b. W 加高电平, 通过 $W \rightarrow T_4 \rightarrow B \rightarrow B_1 \rightarrow C_1$ 充电至高电平,
使 T_1 导通。

T_1 导通, T_2 截止 (C_1 有电荷, C_2 无电荷) : 电路处于0状态

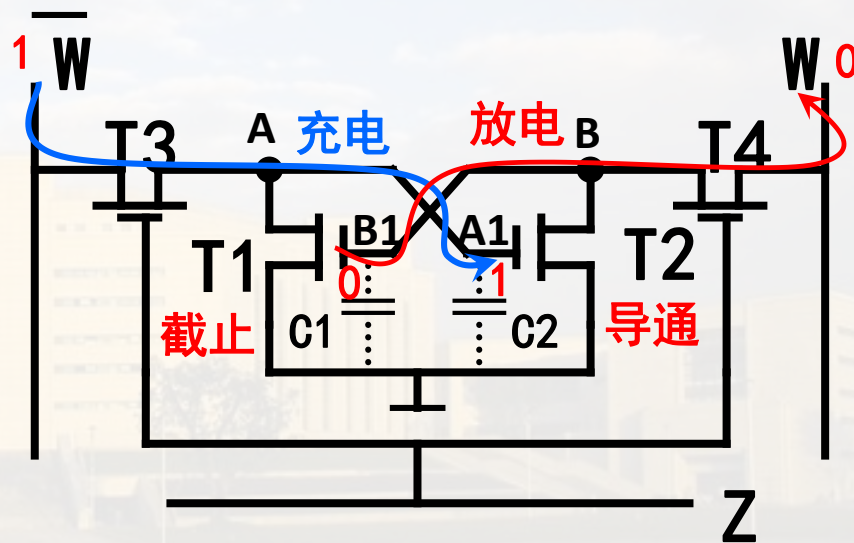


二、动态MOS存储单元与存储芯片

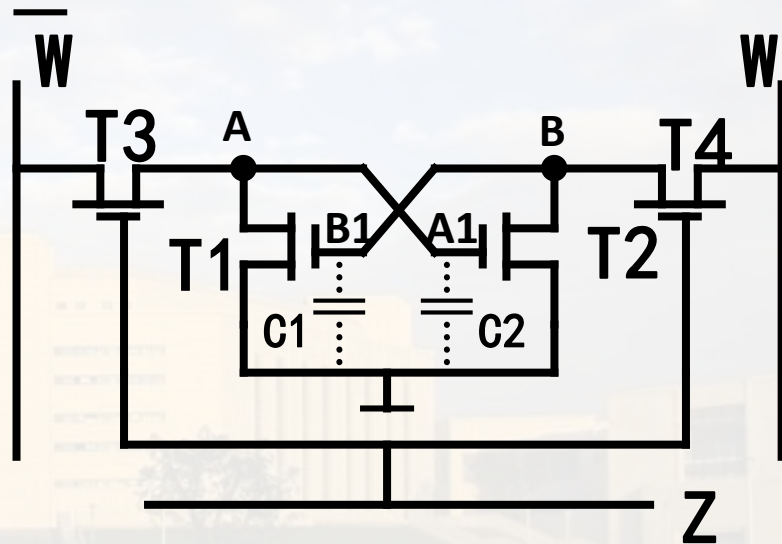
写“1”：

- \bar{W} 加高电平, $\bar{W} \rightarrow T_3 \rightarrow A \rightarrow A_1 \rightarrow C_2$ 充电至高电平,使 T_2 导通。
- W 加低电平, $C_1 \rightarrow B_1 \rightarrow B \rightarrow T_4 \rightarrow$ 对 W 放电。

T_1 截止, T_2 导通 (C_1 无电荷, C_2 有电荷)：电路处于1状态。



字线Z加低电平时, T_3 、 T_4 断开, 基本上无放电回路, 仅存在
泄漏电流, 信息可暂存数毫秒。

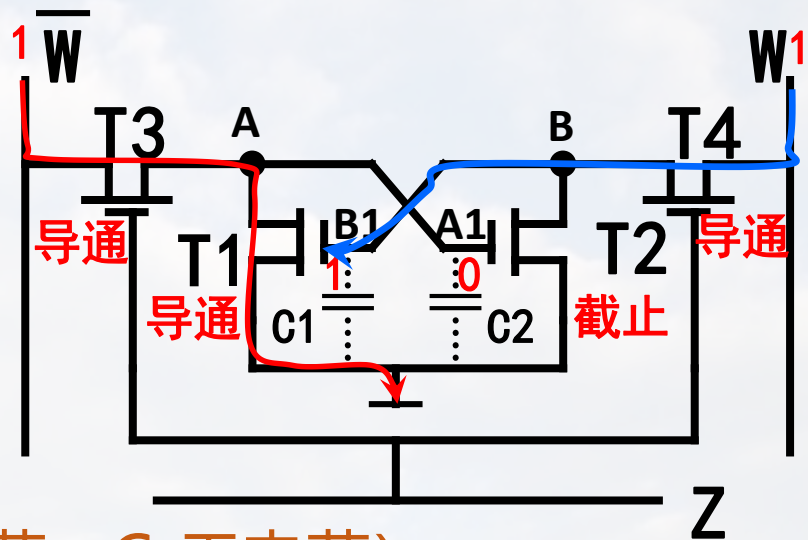


先对位线 W 、 \bar{W} 充电至高电平，该电平是浮动的；然后对字线 Z 加高电平，使 T_3 、 T_4 导通。

“0”：T₁导通，T₂截止（C₁有电荷，C₂无电荷）；

C_1 上有电荷, V_{B1} 为高电平, T_1 导通, $\bar{W} \rightarrow T_3 \rightarrow A \rightarrow T_1 \rightarrow$ 对地放电, 即 \bar{W} 上有电流通过, 放大后作为0信号读出;

同时, $W \rightarrow T_4 \rightarrow B \rightarrow B_1 \rightarrow C_1$ 充电至高电平, 补充泄漏掉的电荷。四管单元为**非破坏性读出**, 且读出过程为刷新过程。



二、动态MOS存储单元与存储芯片

读“1”：

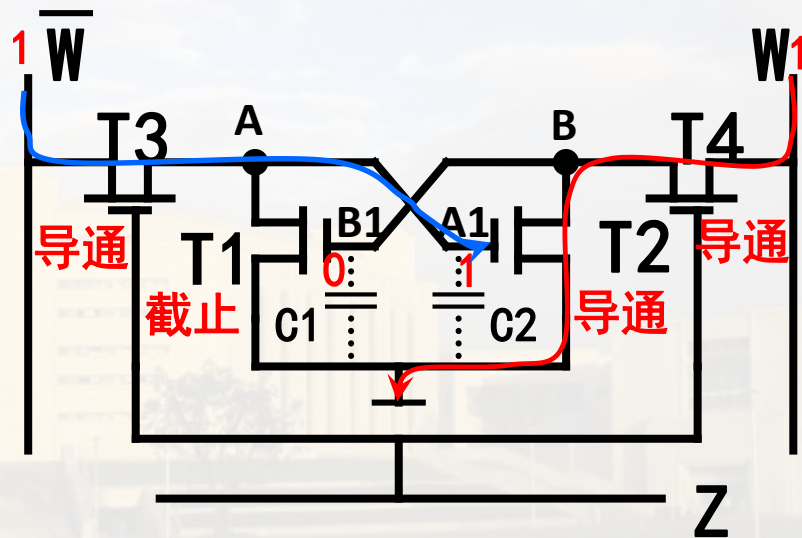
“1”： T_1 截止， T_2 导通（ C_1 无电荷， C_2 有电荷）。

C_2 上有电荷， V_{A1} 为高电平， T_2 导通， $W \rightarrow T_4 \rightarrow B \rightarrow T_2 \rightarrow$ 对地放电，即 W 上有电流通过，放大后作为1信号读出；

同时， $\bar{W} \rightarrow T_3 \rightarrow A \rightarrow A_1 \rightarrow C_2$ 充电至高电平，补充泄漏掉的电荷四管单元为非破坏性读出，且读出过程为刷新过程。

\bar{W} 上有电流为0， W 上有电流为1。

注：读出过程就是刷新过程。



4、单管单元

1) 组成

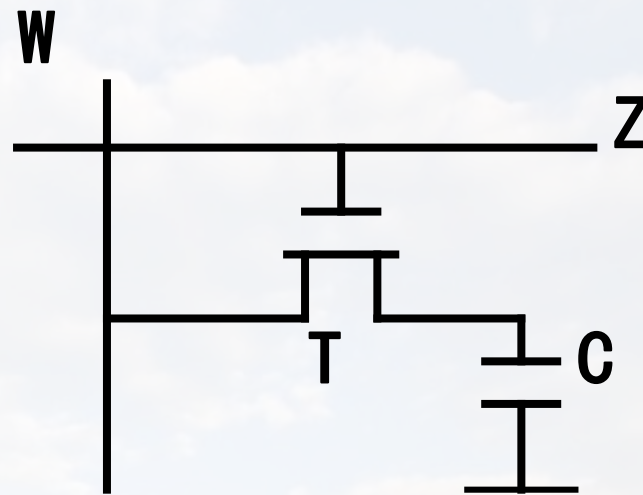
C: 记忆单元 T: 控制门管

Z: 字线 W: 位线

2) 定义

"0" : C无电荷, 电平 V_0 (低)

"1" : C有电荷, 电平 V_1 (高)



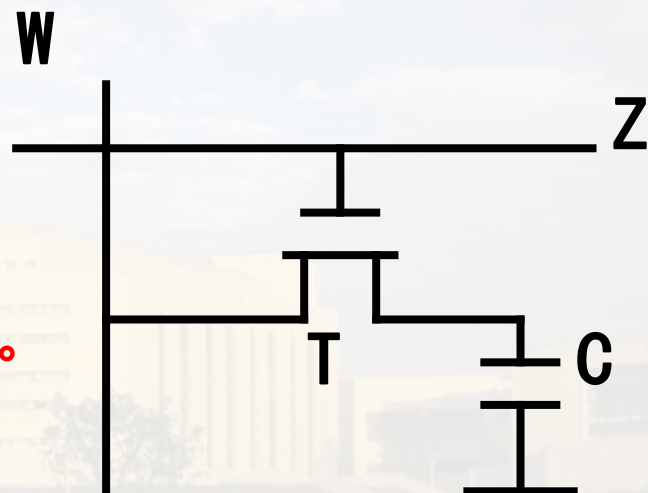
3) 工作

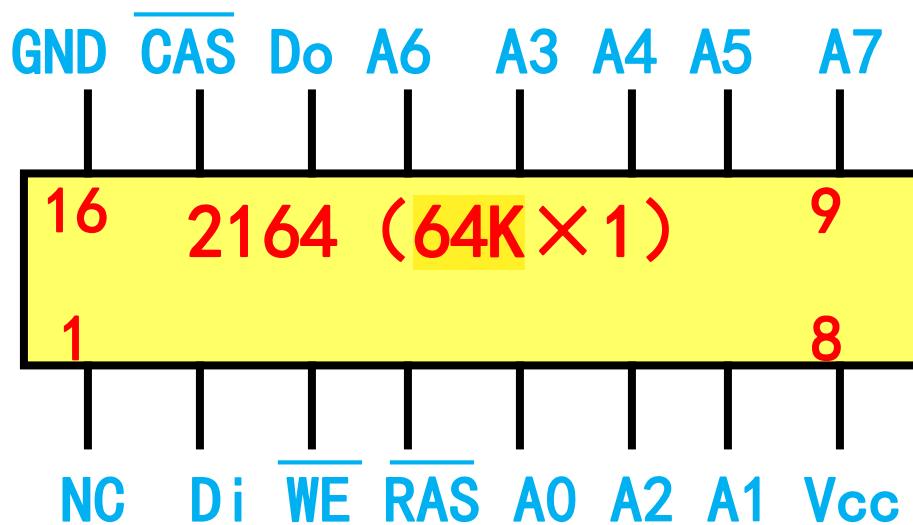
写入: Z加高电平, T导通, 在W上加高/低电平, 写1/0。

保持: Z加低电平, T截止, 该单元未选中, 保持原状态。

读出: W先预充电, 断开充电回路。Z加高电平, T导通, 根据W线电位的变化, 读1/0。

单管单元是破坏性读出, 读出后需重写。





地址端：A7 ~ A0 (入)

分时复用

数据端：{ Di (入)
Do (出)

控制端：{ 写使能 \overline{WE} { = 0 写
= 1 读
片选 { 行选 \overline{RAS} = 0 时 A7 ~ A0 为行地址
列选 \overline{CAS} = 0 时 A7 ~ A0 为列地址

高8位地址

低8位地址

电源、地

1脚未用，或在新型号中用于片内自动刷新。



谢谢观看

计算机组成原理

2022/10/26



信息与软件工程学院

School of Information and Software Engineering